

Dimanche 16mai		Lundi 17 mai		Mardi 18 mai		Mercredi 19 mai		Jeudi 20 mai	
		7h00 – 8h00	Petit déjeuner au CSA	7h00–8h00	Petit déjeuner au CSA	7h00–8h00	Petit déjeuner au CSA	7h00–8h00	Petit déjeuner au CSA
		Accueil à l'UTT		Particularités technologiques des Grands Gaps		Technologie quantique		Ateliers NanoMat (8h15 - 12h30)	
		8h00 - 8h30	Accueil à l'UTT	8h15-9h00	Konstantinos Zekentes - IMEP-LAHC Grenoble Technologie SiC pour le bio-médical et autres applications	8h15-9h00	Vincent Jacques - L2C Montpellier Applications des défauts ponctuels dans les matériaux à grand gap pour les technologies quantiques	X005sb	Structuration du et par ZnO avec lithographie interférentielle et PEC
		8h30 - 9h00	Présentation de l'école thématique						
		Elaboration des Grands Gaps, du bulk au couches 2D		9h00-9h45	Gilles Lerondel -L2n Troyes Photonique UV à base de ZnO, structuration avancée et intégration matériaux 2D	9h00-9h45	Jean-Marie Bluet - INL Lyon Ingénierie des centres colorés dans SiC pour la photonique et la solotronique	X007sb	Identification et signature d'un centre coloré en diamant
		9h00-9H45	Didier Chaussende - SIMAP Grenoble Les procédés de croissance des cristaux massifs de grand gaps						
		9h45-10h30	Alexandre Tallaire - IRCP Paris Croissance diamant par CVD et incorporation de centres colorés	9h45-10h30	Ali Belarouci -INL Lyon Micro-nanophotonique sur la plateforme SiC	9h45-10h30	Jérôme Tribollet - Institut Chimie de Strasbourg Implantation ionique et Résonance Paramagnétique Electronique : des outils clés pour les technologies quantiques	X013sb et X003sb	Fabrication d'une LED SiC et tests en électroluminescence
		10h30-11h00	Pause café	10h30-11h00	Pause café	10h30-11h00	Pause café	X001sb	µRaman UV 325nm sur SiC et GaN, quantification du dopage
		11h00-11h45	Gabriel Ferro - LMI Lyon Homo et hétéro-épitaxy du carbure de silicium	11h00-11h45	Marie-Laure Locatelli -LAPLACE Toulouse Les matériaux diélectriques isolants au sein des dispositifs de puissance à semi-conducteur grand-gaps	Dispositifs de puissance aujourd'hui et perspectives (1)			
						11h00-11h45	Etienne Gheeraert NEEL Grenoble Dispositifs de puissance diamant – approche matériau		
		11h45-12h30	Abdallah Ougazzaden -Georgia Tech Van der Waals epitaxy by MOCVD of III-Nitrides using two-dimensional hexagonal boron nitride: applications and perspectives	11h45-12h30	Eric Guiot – SOITEC Bernin Layer transfer of wide band gap materials: technology and applications	11h45-12h30	Nicolas Rouger - LAPLACE Toulouse Dispositifs de puissance diamant – approche système		
		12h30-14h00	Pause déjeuner	12h30-14h00	Pause déjeuner	12h30-14h00	Pause déjeuner	12h30-14h00	Pause déjeuner
		Applications "classiques" et perspectives		Capteurs et instrumentation		Dispositifs de puissance aujourd'hui et perspectives (2)			
		14h00-14h45	Christian Brylinski - LMI Lyon Hétérojonctions à matériaux grand-gap: dispositifs, enjeux et perspectives	14h00-14h45	Yamin Leprince -ESYCOM Paris Nanostructures de ZnO pour le développement de routes dépolluantes photocatalytiques	14h00-14h45	Hervé Morel - AMPERE Lyon Composants WBG: quels impacts sur la commutation		
17h-19h	Accueil au CSA Troyes	14h45-15h30	Daniel Alquier - GREMAN Tours Technologie MEMS et NEMS grand-gaps	14h45-15h30	Laurent Ottaviani -IM2NP Marseille DéTECTeurs de neutrons à base de SiC pour environnement nucléaire	14h45-15h30	Bertrand Vergne - ISL Saint-Louis Enjeux liés à la caractérisation des composants à grand gap		
		15h30-16h15	Karine Isoird - LAAS Toulouse Les WBG pour la puissance	15h30-16h15	Lionel Rousseau - ESIEE Paris Applications du diamant aux interfaces Neuronales, enjeu et perspectives				
		16h15-16h30	Pause café	16h15-16h30	Pause café	15h30-16h00	Pause café		
		16h30-17h15	Ekaterine Chikoidze – GEMAC Versailles Gallium Oxide's outstanding potential for Energy Electronics	16h30-17h15	Yacine Halfaya - GT Lorraine AlGaN/GaN HEMT based gas sensors for extreme conditions	16h00-16h45	Frédéric Richardeau -LAPLACE Toulouse Robustesse du Mosfet SiC en régime extrême de court-circuit – Propriétés physiques et technologiques – Modes de défaillance		
		17h15-18h00	Dave Rogers – Nanovation -Versailles Ga ₂ O ₃ : Le Nouvel Arrivant sur la Scène des Semiconducteurs UWBG – applications: puissance, capteurs UVC et solaire	17h15-18h00	Aurélien Bruyant - L2n Troyes Nanospectroscopie IR – opportunités pour les matériaux grand-gaps	16h45-17h30	Tanguy Phulpin - GeePs Paris Défaillance ESD dans composants SiC et GaN		

